

四楕円鏡型浮遊帯域溶融装置

型式 : FZ-T-10000-H-VIII-VPM-MII-PC



Crystal Systems Corp.

株式会社クリスタルシステム

〒408-0044 山梨県北杜市小淵沢町 9633 番地 1

TEL 0551-36-5271 FAX 0551-36-5273

<http://www.crystalsys.co.jp> e-mail: csc@crystalsys.co.jp

1. 装置仕様書

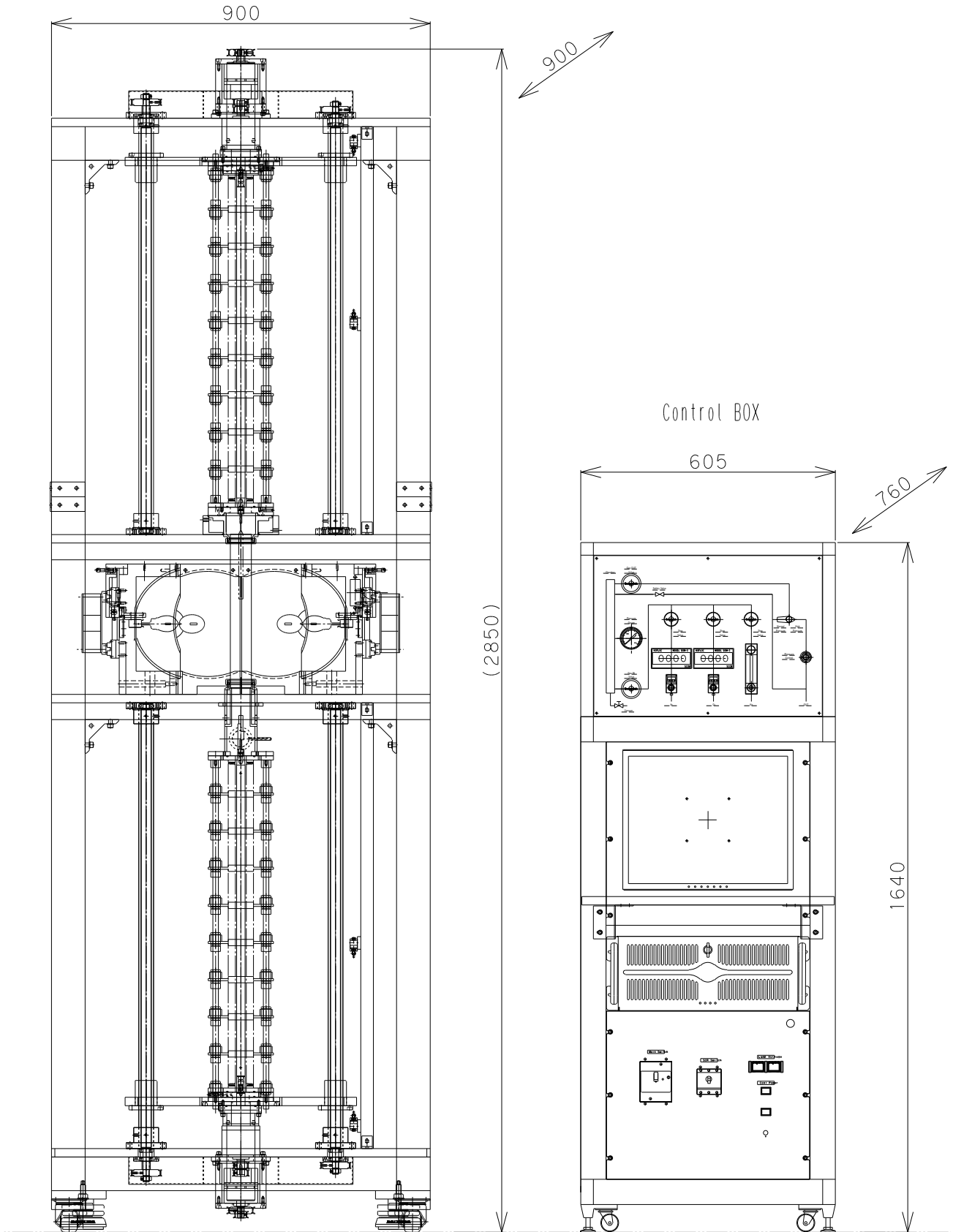
型式	FZ-T-10000-H-VIII-VPM-MII-PC		
使用ランプ種類	ハロゲン		
使用ランプ、ミラー個数	4 (個)		
最高到達圧力	0.95 (MPa)		
最高到達真空度	5×10^{-5} (Torr) (6.7×10^{-3} Pa)		
シャフト部シール方式	磁性流体シール+高圧ベローズ		
最高到達温度	2,200 (°C)		
常用使用温度	1,850 (°C)		
標準具備ランプ	300 (W)		
(各ランプは4本一組、各2組を標準 装備)	1,000 (W)		
	1,500 (W)		
円周方向温度差	30 (°C以下)		
ランプ冷却方式	空冷		
ミラー冷却方式	空冷		
石英管シール冷却方式	水冷		
シャフト/ミラーステージ	上下シャフト移動 / ミラーステージ固定		
下シャフト移動長(結晶育成長)	最大移動長 350 (mm) 結晶育成長 150 (mm)		
上シャフト移動長(原料棒供給長)	350 (mm)		
最大原料棒長	150 (mm)		
下シャフト(結晶育成)速度遅送り	0.01~300 (mm/hr)		
下シャフト移動速度早送り	6~150 (mm/min)		
上シャフト移動速度遅送り	0.01~300 (mm/hr)		
上シャフト移動速度早送り	6~150 (mm/min)		
上下シャフト回転速度	5~100 (rpm)		
溶融域観察方式	CMOS カメラ		
雰囲気ガス流量制御	マスフローコントローラー：①Ar 5 (L/min) ②O ₂ 500 (cc/min) フロート式フローメーター：③Air 10 (L/min) (Compressor 付)		
ランプ出力制御方式	プログラム式出力調整 (4本を一括制御)		
出力安定度	入力変動±10 (%)に対して±0.2 (%)以下		
用力	電力	三相 200 (V), 40 (A)	
	冷却水	3 (L/min)	
装置寸法 (mm)	本体		制御盤(ガス BOX 含む)
	幅	900	605
	奥行	900	760
	高さ	2,850	1,640

注) 上記仕様は断り無く変更することがあります。 随時、営業担当者にお問い合わせ下さい。

3. 参考図

FZ Furnace

FZ-T-10000-H-VIII-VPM-MII-PC



4. 配置图

